

КПС104Г, Транзисторная матрица

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером.

Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

КПС104Г матрицы полупроводниковой:

КПС104Г — транзисторная матрица (артикулярное наименование по ГОСТ) транзисторы кремний эпитаксиальнопланарные ионнолегированные полевые с затвором PN перехода каналом P спаренные, назначение для применения в входящих каскадах дифференциальных мало шумящих усилителей НЧ и постоянного тока с большим сопротивлением на входе. Сборки биполярные полевые полупроводниковые используются в РЭА в широком спектре использования. Матрицы выполнены металлостеклянным корпусе с гибкими выводами. Модель прибора, знак завода и дата выпуска наносится на металлической части корпуса. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует 2) техническим условиям аА0.339.033ТУ.

Ссылки на технические материалы

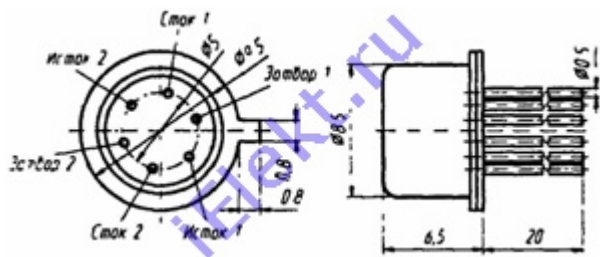
ссылки на дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	габариты	параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположения выводов схематическое, назначение выводов, габаритные размеры, маркировка



Вес не превышает 2g.

Основные электро параметры при $t=25\pm 10$ градусов Цельсия

основные электро параметры:

Наименование параметра (режим замера), единица замера	Допуск	
	больше	меньше
Крутизна характеристики отдельного транзистора в паре, mA/V при $U_{си}=10V$, $U_{зи}=0$: $T=+25^{\circ}C$: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б	0,35	
типичное значение	0,8	
2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е	0,65	
типичное значение	1	
2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д	1	
типичное значение	1,7	
$T=-60^{\circ}C$: 2ПС104А, 2ПС104Б	0,35	
2ПС104В, 2ПС104Е	0,65	
2ПС104Г, 2ПС104Д	1	
$T=-45^{\circ}C$: КПС104А, КПС104Б	0,35	
КПС104В, КПС104Е	0,65	
КПС104Г, КПС104Д	1	
$T=+125^{\circ}C$: 2ПС104А, 2ПС104Б	0,25	
2ПС104В, 2ПС104Е	0,3	
2ПС104Г, 2ПС104Д	0,5	
$T=+85^{\circ}C$: КПС104А, КПС104Б	0,25	
КПС104В, КПС104Е	0,3	
КПС104Г, КПС104Д	0,5	
Шумовой вольтаж отдельного транзистора в полосе частот $\Delta f=0,1\dots 10Hz$, uV, при $U_{си}=10V$, $R_n=30k\Omega$, $I_c=0,18mA$ для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, $I_c=0,5mA$ для двух транзисторов 2ПС104В, КПС104В, $I_c=1,5mA$ для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д: 2ПС104А, КПС104А		0,4
типичное значение		0,35
2ПС104Б, 2ПС104Г, КПС104Б, КПС104Г		1
типичное значение		0,8
2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104В, КПС104Д		5
типичное значение		1,5
Разность вольтажей затвор/исток, mV, при $U_{си}=10V$, $I_c=0,18mA$ для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, $I_c=0,5mA$ для двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е, $I_c=1,5mA$ для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д: $T=+25^{\circ}C$: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б		30
типичное значение		10

2ПС104В, 2ПС104Г, КПС104В, КПС104Г		50
типовое значение		10
2ПС104Е, КПС104Е		20
типовое значение		10
$T=+85^{\circ}\text{C}$: КПС104А, КПС104Б, КПС104Е		60
КПС104В, КПС104Г, КПС104Д		70
$T=+125^{\circ}\text{C}$: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е		60
2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д		70
Температурный уход разности вольтажа затвор/исток, $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$, при $U_{\text{си}}=10\text{V}$, $I_{\text{с}}=0,18\text{mA}$ для двух транзисторов 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б, $I_{\text{с}}=0,5\text{mA}$ для двух транзисторов 2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е, $I_{\text{с}}=1,5\text{mA}$ для двух транзисторов 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д; 2ПС104А, КПС104А		50
типовое значение		20
2ПС104Б, 2ПС104В, 2ПС104Д, КПС104Б, КПС104В, КПС104Д		150
типовое значение		50
2ПС104Г, КПС104Г		100
2ПС104Е, КПС104Е		20
типовое значение		10
Вольтаж отсечки (отрицательное) отдельного транзистора в паре, V , при $U_{\text{си}}=10\text{V}$, $I_{\text{с}}=10\mu\text{A}$: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б	0,2	1
2ПС104В, 2ПС104Е, КПС104В, КПС104Е	0,4	2
2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д	0,8	3
Начальный ампераж стока отдельного транзистора в паре, mA , при $U_{\text{си}}=10\text{V}$, $U_{\text{зи}}=0$: 2ПС104А, 2ПС104Б, КПС104А, КПС104Б	0,1	0,8
2ПС104В, КПС104В	0,35	1,5
2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104Г, КПС104Д	1,1	3
2ПС104Е, КПС104Е	0,35	3
Ампераж утечки затвора отдельного транзистора в паре, nA , при $U_{\text{си}}=0$, $U_{\text{зи}}=-10\text{V}$: $T=+25^{\circ}\text{C}$: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е, КПС104А, КПС104Б, КПС104Е		0,3
типовое значение		0,1
2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, КПС104В, КПС104Г, КПС104Д		1
типовое значение		0,3
$T=+85^{\circ}\text{C}$: КПС104А, КПС104Б, КПС104Е, μA		0,15
КПС104В, КПС104Г, КПС104Д, μA		0,15
$T=+125^{\circ}\text{C}$: 2ПС104А, 2ПС104Б, 2ПС104Е, μA		0,3
2ПС104В, 2ПС104Г, 2ПС104Д, μA		1
Входная емкость отдельного транзистора в паре, pF , $U_{\text{си}}=10\text{V}$, $U_{\text{зи}}=0$		4,5
Проходная емкость отдельного транзистора, pF , при $U_{\text{си}}=10\text{V}$, $U_{\text{зи}}=0$		1,5

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск,

Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.